



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 7月13日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-213543

出 願 人

Applicant(s):

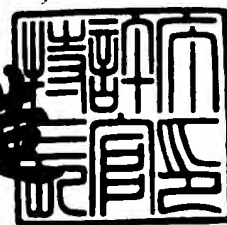
ティーディーケイ株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3070941

【書類名】 特許願

【整理番号】 TD03078

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 05/39

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 稲毛 健治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 工藤 良弘

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 高野 研一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 照沼 幸一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 岩井 譲

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107559

【弁理士】

【氏名又は名称】 星宮 勝美

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-237366

【出願日】 平成12年 8月 4日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 064839

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気抵抗効果装置およびその製造方法ならびに薄膜磁気ヘッド
およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 互いに反対側を向く 2 つの面と、それぞれ前記 2 つの面を連結する 2 つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、

前記磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層と、

それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す 2 つの電極層とを備えた磁気抵抗効果装置であって、

前記 2 つのバイアス磁界印加層は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

前記 2 つの電極層のうちの少なくとも一方は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さは $0.3 \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする磁気抵抗効果装置。

【請求項 2】 前記 2 つの電極層は共に前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に $0.15 \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする請求項 1 記載の磁気抵抗効果装置。

【請求項 3】 前記 2 つの電極層の間隔は $0.6 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の磁気抵抗効果装置。

【請求項 4】 互いに反対側を向く 2 つの面と、それぞれ前記 2 つの面を連結する 2 つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、

前記磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層と、

それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す 2 つの電極層と

を備えた磁気抵抗効果装置の製造方法であって、

前記磁気抵抗効果素子を形成する工程と、

前記バイアス磁界印加層を形成する工程と、

前記電極層を形成する工程とを含み、

前記 2 つのバイアス磁界印加層は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

前記 2 つの電極層のうちの少なくとも一方は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さは $0.3 \mu\text{m}$ 未満である

ことを特徴とする磁気抵抗効果装置の製造方法。

【請求項 5】 前記 2 つの電極層は共に前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に $0.15 \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする請求項 4 記載の磁気抵抗効果装置の製造方法。

【請求項 6】 前記 2 つの電極層の間隔は $0.6 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 4 または 5 記載の磁気抵抗効果装置の製造方法。

【請求項 7】 互いに反対側を向く 2 つの面と、それぞれ前記 2 つの面を連結する 2 つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、

前記磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層と、

それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す 2 つの電極層とを備えた薄膜磁気ヘッドであって、

前記 2 つのバイアス磁界印加層は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

前記 2 つの電極層のうちの少なくとも一方は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さは $0.3 \mu\text{m}$ 未満である

ことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項 8】 前記 2 つの電極層は共に前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に $0.15\ \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする請求項 7 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 9】 前記 2 つの電極層の間隔は $0.6\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 7 または 8 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 10】 互いに反対側を向く 2 つの面と、それぞれ前記 2 つの面を連結する 2 つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、

前記磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層と、

それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、前記磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す 2 つの電極層とを備えた薄膜磁気ヘッドの製造方法であって、

前記磁気抵抗効果素子を形成する工程と、

前記バイアス磁界印加層を形成する工程と、

前記電極層を形成する工程とを含み、

前記 2 つのバイアス磁界印加層は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

前記 2 つの電極層のうちの少なくとも一方は、前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さは $0.3\ \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 11】 前記 2 つの電極層は共に前記磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に $0.15\ \mu\text{m}$ 未満であることを特徴とする請求項 10 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項 12】 前記 2 つの電極層の間隔は $0.6\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 10 または 11 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、磁気抵抗効果素子を有する磁気抵抗効果装置およびその製造方法、ならびに磁気抵抗効果素子を有する薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、ハードディスク装置の面記録密度の向上に伴って、薄膜磁気ヘッドの性能向上が求められている。薄膜磁気ヘッドとしては、読み出し用の磁気抵抗効果素子（以下、MR（Magneto-resistive）素子とも記す。）を有する再生ヘッドと書き込み用の誘導型電磁変換素子を有する記録ヘッドとを積層した構造の複合型薄膜磁気ヘッドが広く用いられている。

【 0 0 0 3 】

MR素子としては、異方性磁気抵抗（Anisotropic Magneto-resistive）効果を用いたAMR素子や、巨大磁気抵抗（Giant Magneto-resistive）効果を用いたGMR素子や、トンネル磁気抵抗（Tunnel-type Magnetoresistive）効果を用いたTMR素子等がある。

【 0 0 0 4 】

再生ヘッドの特性としては、高感度および高出力であることが要求される。この要求を満たす再生ヘッドとして、既に、スピバルブ型GMR素子を用いたGMRヘッドが量産されている。

【 0 0 0 5 】

再生ヘッドの特性としては、更に、バルクハウゼンノイズが小さいことが要求される。バルクハウゼンノイズは、MR素子における磁区の磁壁の移動に起因して発生するノイズである。このバルクハウゼンノイズが発生すると、出力が急激に変化するため、信号対雑音比（SN比）の低下、エラーレートの増加をまねく。

【 0 0 0 6 】

バルクハウゼンノイズを低減する手段としては、MR素子に対して長手方向に

バイアス磁界（以下、縦バイアス磁界とも言う。）を印加することが行われている。MR素子に対する縦バイアス磁界の印加は、例えば、MR素子の両側に、永久磁石や、強磁性層と反強磁性層との積層体等によって構成されたバイアス磁界印加層を配置することによって行われる。

【 0 0 0 7 】

MR素子の両側にバイアス磁界印加層を配置した構造の再生ヘッドでは、MR素子に信号検出用の電流（以下、センス電流と言う。）を流すための2つの電極層は、バイアス磁界印加層に接するように配置される。

【 0 0 0 8 】

ところで、例えば特開平 1 1 - 3 1 3 1 3 号公報に記載されているように、MR素子の両側にバイアス磁界印加層を配置すると、MR素子においてバイアス磁界印加層に隣接する端部近傍に、バイアス磁界印加層からの磁界によって磁化の方向が固定されて信号磁界を感知することができない領域（以下、不感領域と言う。）が生じることが知られている。

【 0 0 0 9 】

そのため、電極層をMR素子に重ならないように配置した場合には、センス電流が不感領域を通過するため、再生ヘッドの出力が低下するという問題があった。

【 0 0 1 0 】

この問題を解決するために、特開平 8 - 4 5 0 3 7 号公報、特開平 9 - 2 8 2 6 1 8 号公報、特開平 1 1 - 3 1 3 1 3 号、特開 2 0 0 0 - 7 6 6 2 9 号公報等
に示されるように、電極層をMR素子に部分的に重なる（以下、オーバーラップ
すると言う。）ように配置することが行われている。

【 0 0 1 1 】

ここで、一方の電極層がMR素子にオーバーラップする領域の長さ、すなわち一方の電極層の端部とそれに対応するMR素子の一方の端部との距離（以下、オーバーラップ量と言う。）に注目する。特開平 8 - 4 5 0 3 7 号公報には、特にオーバーラップ量の範囲は記載されていない。特開平 9 - 2 8 2 6 1 8 号公報に記載されているオーバーラップ量の範囲は 0. 2 5 ~ 2 μ m になっている。特開

平 1 1 - 3 1 3 1 3 号に記載されているオーバーラップ量の範囲は $0.15 \sim 0.5 \mu\text{m}$ になっている。また、特開 2 0 0 0 - 7 6 6 2 9 号公報に記載されているオーバーラップ量の範囲は $0.15 \sim 5 \mu\text{m}$ になっている。

【 0 0 1 2 】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、再生ヘッドを、MR素子の両側にバイアス磁界印加層を配置すると共に電極層をMR素子にオーバーラップするように配置した構造（以下、電極層オーバーラップ構造と言う。）とすることによって、再生ヘッドの出力の低下を防止しながら、バルクハウゼンノイズを低減することが可能になる。

【 0 0 1 3 】

しかしながら、本発明者の研究により、電極層オーバーラップ構造の再生ヘッドでは、2つの電極層の間隔すなわち光学的な磁氣的読み出しトラック幅と、実効的な磁氣的読み出しトラック幅とが異なることが分かった。更に、前記の各公報に記載されているオーバーラップ量の範囲では、光学的な磁氣的読み出しトラック幅と実効的な磁氣的読み出しトラック幅との差、および実効的な磁氣的読み出しトラック幅のばらつきが大きく、再生ヘッドの特性上および歩留まり上、問題があることが分かった。

【 0 0 1 4 】

なお、特開 2 0 0 0 - 1 8 7 8 1 3 号公報には、スピバルブ膜の感磁部の幅 L_2 と永久磁石膜および電極膜が感磁部にオーバーラップする部分の長さ L_1 との比 L_1 / L_2 を $0 \sim 10\%$ にする技術が開示されている。この技術は、永久磁石膜がスピバルブ膜にオーバーラップすることによるノイズの発生を防止することを目的としている。前記公報には、感磁部に永久磁石膜のみがオーバーラップする構造と、感磁部に永久磁石膜と電極膜の双方がオーバーラップする構造とが開示されているが、感磁部に永久磁石膜はオーバーラップせずに、電極膜のみがオーバーラップする構造は開示されていない。

【 0 0 1 5 】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、感度、出力および出力安定性を向上させると共に、実効読み出しトラック幅を精度よく決定でき

るようにした磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドならびにそれらの製造方法を提供することにある。

【 0 0 1 6 】

【課題を解決するための手段】

本発明の磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドは、

互いに反対側を向く2つの面と、それぞれ2つの面を連結する2つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、

磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する2つのバイアス磁界印加層と、

それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す2つの電極層とを備え、

2つのバイアス磁界印加層は、磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

2つの電極層のうちの少なくとも一方は、磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さは0.3 μm 未満であるものである。

【 0 0 1 7 】

本発明の磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドでは、バイアス磁界印加層を設けると共に、2つのバイアス磁界印加層を、磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置し、2つの電極層のうちの少なくとも一方を、磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置することにより、磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドの感度、出力および出力安定性が向上する。更に、本発明では、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さを0.3 μm 未満とすることにより、実効読み出しトラック幅を精度よく決定することが可能になる。

【 0 0 1 8 】

本発明の磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドにおいて、2つの電極層は共に磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に0.15 μm 未満であって

もよい。

【 0 0 1 9 】

また、本発明の磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドにおいて、2つの電極層の間隔は $0.6\mu\text{m}$ 以下であってもよい。

【 0 0 2 0 】

本発明の磁気抵抗効果装置の製造方法は、互いに反対側を向く2つの面と、それぞれ2つの面を連結する2つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する2つのバイアス磁界印加層と、それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す2つの電極層とを備えた磁気抵抗効果装置を製造する方法である。

【 0 0 2 1 】

本発明の薄膜磁気ヘッドの製造方法は、互いに反対側を向く2つの面と、それぞれ2つの面を連結する2つの側部とを有する磁気抵抗効果素子と、磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対してバイアス磁界を印加する2つのバイアス磁界印加層と、それぞれ各バイアス磁界印加層の一方の面に隣接するように配置され、磁気抵抗効果素子に対して信号検出用の電流を流す2つの電極層とを備えた薄膜磁気ヘッドを製造する方法である。

【 0 0 2 2 】

本発明の磁気抵抗効果装置の製造方法または薄膜磁気ヘッドの製造方法は、
磁気抵抗効果素子を形成する工程と、
バイアス磁界印加層を形成する工程と、
電極層を形成する工程とを含み、

2つのバイアス磁界印加層は、磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置され、

2つの電極層のうちの少なくとも一方は、磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さが $0.3\mu\text{m}$ 未満であるものである。

【 0 0 2 3 】

本発明の磁気抵抗効果装置の製造方法または薄膜磁気ヘッドの製造方法では、バイアス磁界印加層を設けると共に、2つのバイアス磁界印加層を、磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置し、2つの電極層のうちの少なくとも一方を、磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置することにより、磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドの感度、出力および出力安定性が向上する。更に、本発明では、電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さを $0.3\mu\text{m}$ 未満とすることにより、実効読み出しトラック幅を精度よく決定することが可能になる。

【0024】

本発明の磁気抵抗効果装置の製造方法または薄膜磁気ヘッドの製造方法において、2つの電極層は共に磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置され、各電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の長さは共に $0.15\mu\text{m}$ 未満であってもよい。

【0025】

また、本発明の磁気抵抗効果装置の製造方法または薄膜磁気ヘッドの製造方法において、2つの電極層の間隔は $0.6\mu\text{m}$ 以下であってもよい。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

〔第1の実施の形態〕

始めに、図3ないし図6を参照して、本発明の第1の実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法の概略について説明する。なお、図3ないし図6において、(a)はエアベアリング面に垂直な断面を示し、(b)は磁極部分のエアベアリング面に平行な断面を示している。

【0027】

本実施の形態における薄膜磁気ヘッドの製造方法では、まず、図3に示したように、アルティック($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiC}$)等のセラミック材料よりなる基板1の上に、スパッタ法等によって、アルミナ(Al_2O_3)、二酸化ケイ素(SiO_2)等の絶縁材料よりなる絶縁層2を、例えば $1 \sim 20\mu\text{m}$ の厚さに形成する。次

に、絶縁層 2 の上に、磁性材料よりなる再生ヘッド用の下部シールド層 3 を、例えば $0.1 \sim 5 \mu\text{m}$ の厚さに形成する。下部シールド層 3 に用いる磁性材料は、 FeAlSi 、 NiFe 、 CoFe 、 CoFeNi 、 FeN 、 FeZrN 、 FeTaN 、 CoZrNb 、 CoZrTa 等である。下部シールド層 3 は、スパッタ法またはめっき法等によって形成される。

【 0 0 2 8 】

次に、下部シールド層 3 の上に、スパッタ法等によって、 Al_2O_3 、 SiO_2 等の絶縁材料よりなる下部シールドギャップ膜 4 を、例えば $10 \sim 200 \text{ nm}$ の厚さに形成する。次に、下部シールドギャップ膜 4 の上に、スパッタ法等によって、再生用の MR 素子（磁気抵抗効果素子）5 を、例えば数十 nm の厚さに形成する。次に、図示しないが、スパッタ法等によって、下部シールドギャップ膜 4 の上において MR 素子 5 の各側部に隣接するように、MR 素子 5 に対して縦バイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層を形成する。次に、下部シールドギャップ膜 4 およびバイアス磁界印加層の上に、スパッタ法等によって、MR 素子 5 に電氣的に接続される一対の電極層 6 を、数十 nm の厚さに形成する。次に、下部シールドギャップ膜 4 および MR 素子 5 の上に、スパッタ法等によって、 Al_2O_3 、 SiO_2 等の絶縁材料よりなる上部シールドギャップ膜 7 を、例えば $10 \sim 200 \text{ nm}$ の厚さに形成する。

【 0 0 2 9 】

なお、上記の再生ヘッドを構成する各層は、レジストパターンを用いた一般的なエッチング方法やリフトオフ法やこれらを併用した方法によってパターニングされる。

【 0 0 3 0 】

次に、上部シールドギャップ膜 7 の上に、磁性材料からなり、再生ヘッドと記録ヘッドの双方に用いられる上部シールド層兼下部磁極層（以下、上部シールド層と記す。）8 を、例えば $0.5 \sim 4.0 \mu\text{m}$ の厚さに形成する。なお、上部シールド層 8 に用いる磁性材料は、 NiFe 、 CoFe 、 CoFeNi 、 FeN 等の軟磁性材料である。上部シールド層 8 は、スパッタ法またはめっき法等によって形成される。

【 0 0 3 1 】

次に、上部シールド層 8 の上に、スパッタ法等によって、 Al_2O_3 、 SiO_2 等の絶縁材料よりなる記録ギャップ層 9 を、例えば $10 \sim 500 \text{ nm}$ の厚さに形成する。次に、磁路形成のために、後述する薄膜コイルの中心部分において、記録ギャップ層 9 を部分的にエッチングしてコンタクトホール 9 a を形成する。

【 0 0 3 2 】

次に、記録ギャップ層 9 の上において、薄膜コイルを形成する部分に、例えば熱硬化させたフォトレジストよりなる絶縁層 1 0 を形成する。次に、絶縁層 1 0 の上に、フレイムめっき法等によって、Cu 等の導電性材料よりなる薄膜コイルの第 1 層部分 1 1 を形成する。次に、絶縁層 1 0 および薄膜コイルの第 1 層部分 1 1 を覆うように、例えば熱硬化させたフォトレジストよりなる絶縁層 1 2 を形成する。次に、絶縁層 1 2 の上に、フレイムめっき法等によって、Cu 等の導電性材料よりなる薄膜コイルの第 2 層部分 1 3 を形成する。次に、絶縁層 1 2 および薄膜コイルの第 2 層部分 1 3 を覆うように、例えば熱硬化させたフォトレジストよりなる絶縁層 1 4 を形成する。薄膜コイルの第 1 層部分 1 1 と第 2 層部分 1 3 は、互いに接続され、コンタクトホール 9 a の回りに巻回される。第 1 層部分 1 1 と第 2 層部分 1 3 を合わせた部分の厚さは例えば $2 \sim 5 \mu\text{m}$ とし、絶縁層 1 0, 1 2, 1 4 を合わせた部分の厚さは例えば $3 \sim 20 \mu\text{m}$ とする。

【 0 0 3 3 】

次に、図 4 に示したように、エアベアリング面（媒体対向面）3 0 から絶縁層 1 2, 1 4 の上を経て、コンタクトホール 9 a にかけて、磁性材料からなる記録ヘッド用の上部磁極層 1 5 を、例えば $3 \sim 5 \mu\text{m}$ の厚さに形成する。なお、上部磁極層 1 5 に用いる磁性材料は、NiFe、CoFe、CoFeNi、FeN 等の軟磁性材料である。

【 0 0 3 4 】

下部磁極層（上部シールド層 8）および上部磁極層 1 5 のうち、エアベアリング面 3 0 側において記録ギャップ層 9 を介して互に対向する部分が、それぞれ下部磁極層（上部シールド層 8）の磁極部分および上部磁極層 1 5 の磁極部分である。本実施の形態では、上部磁極層 1 5 の磁極部分は、記録トラック幅に等し

い幅を有し、記録トラック幅を規定している。また、下部磁極層（上部シールド層 8）と上部磁極層 15 は、コンタクトホール 9 a を介して互いに磁氣的に連結されている。

【 0 0 3 5 】

次に、図 5 に示したように、上部磁極層 15 の磁極部分をマスクとして、ドライエッチングにより、記録ギャップ層 9 を選択的にエッチングする。このときのドライエッチングには、例えば、 BCl_2 、 Cl_2 等の塩素系ガスや、 CF_4 、 SF_6 等のフッ素系ガス等のガスを用いた反応性イオンエッチング（RIE）が用いられる。次に、例えばアルゴンイオンミリングによって、上部シールド層 8 を選択的に例えば $0.3 \sim 0.6 \mu\text{m}$ 程度エッチングして、図 5（b）に示したようなトリム構造とする。このトリム構造によれば、狭トラックの書き込み時に発生する磁束の広がりによる実効的なトラック幅の増加を防止することができる。

【 0 0 3 6 】

次に、図 6 に示したように、スパッタ法等によって、全体に、 Al_2O_3 、 SiO_2 等の絶縁材料よりなる保護層 16 を、例えば $5 \sim 50 \mu\text{m}$ の厚さに形成し、その表面を平坦化して、その上に、図示しない電極用パッドを形成する。最後に、上記各層を含むスライダの研磨加工を行って、記録ヘッドおよび再生ヘッドのエアベアリング面 30 を形成して本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドが完成する。

【 0 0 3 7 】

このようにして製造される本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドは、記録媒体に対向する媒体対向面（エアベアリング面 30）と再生ヘッドと記録ヘッドとを備えている。再生ヘッドは、MR 素子 5 と、エアベアリング面 30 側の一部が MR 素子 5 を挟んで対向するように配置された、MR 素子 5 をシールドするための下部シールド層 3 および上部シールド層 8 とを有している。再生ヘッドは、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置でもある。

【 0 0 3 8 】

記録ヘッドは、互いに磁氣的に連結され、エアベアリング面 30 側において互いに対向する磁極部分を含み、それぞれ少なくとも 1 つの層を含む下部磁極層（

上部シールド層 8) および上部磁極層 1 5 と、この下部磁極層 (上部シールド層 8) の磁極部分と上部磁極層 1 5 の磁極部分との間に設けられた記録ギャップ層 9 と、少なくとも一部が下部磁極層 (上部シールド層 8) および上部磁極層 1 5 の間に、これらに対して絶縁された状態で配設された薄膜コイル 1 1, 1 3 とを有している。上部磁極層 1 5 の磁極部分は記録トラック幅を規定している。

【 0 0 3 9 】

次に、図 1 を参照して、本実施の形態における再生ヘッド、すなわち本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置の構成とその製造方法について詳しく説明する。図 1 は本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置のエアベアリング面に平行な断面を示す断面図である。

【 0 0 4 0 】

図 1 に示したように、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置は、互いに反対側を向く 2 つの面と、それぞれ 2 つの面を連結する 2 つの側部とを有する MR 素子 5 と、この MR 素子 5 の各側部に隣接するように配置され、MR 素子 5 に対して縦バイアス磁界を印加する 2 つのバイアス磁界印加層 1 8 と、それぞれ各バイアス磁界印加層 1 8 の一方の面に隣接するように配置され、MR 素子 5 に対して信号検出用の電流であるセンス電流を流す 2 つの電極層 6 とを備えている。図 1 では、電極層 6 はバイアス磁界印加層 1 8 の上に配置されているが、バイアス磁界印加層 1 8 のない領域では、電極層 6 は下部シールドギャップ膜 4 の上に配置されている。磁気抵抗効果装置は、下部シールドギャップ膜 4 と上部シールドギャップ膜 7 とによって覆われている。

【 0 0 4 1 】

磁気抵抗効果装置の製造方法は、下部シールドギャップ膜 4 の上に MR 素子 5 を形成する工程と、下部シールドギャップ膜 4 の上にバイアス磁界印加層 1 8 を形成する工程と、下部シールドギャップ膜 4 およびバイアス磁界印加層 1 8 の上に電極層 6 を形成する工程とを含む。

【 0 0 4 2 】

本実施の形態では、2 つの電極層 6 のうちの少なくとも一方は、MR 素子 5 の一方の面に部分的に重なる (以下、オーバーラップするという。) ように配置さ

れている。2つの電極層6がMR素子5の一方の面にオーバーラップする領域の合計の長さは0.3 μ m未満である。なお、一方の電極層6がMR素子5の一方の面にオーバーラップする領域の長さ（以下、オーバーラップ量と言う。）は、一方の電極層6の端部とそれに対応するMR素子5の一方の端部との距離とする。また、本実施の形態では、2つのバイアス磁界印加層18は、いずれもMR素子5の一方の面にオーバーラップしていない。

【0043】

図2は本実施の形態におけるMR素子5の層の構成を示す斜視図である。本実施の形態におけるMR素子5は、スピバルブ型GMR素子となっている。このMR素子5は、下部シールドギャップ膜4側から順に積層された下地層21、軟磁性層よりなり、記録媒体からの信号磁界に応じて磁化の方向が変化するフリー層22、非磁性の導電層よりなるスペーサ層23、磁化の方向が固定されたピン層24、ピン層24における磁化の方向を固定する反強磁性層25、およびキャップ層26を有している。MR素子5は、上記各層を下部シールドギャップ膜4側から順に積層することによって製造される。

【0044】

このようにMR素子5は、互いに反対側を向く2つの面を有するスペーサ層（非磁性層）23と、このスペーサ層23の一方の面（下面）に隣接するように配置されたフリー層（軟磁性層）22と、スペーサ層23の他方の面（上面）に隣接するように配置され、磁化の方向が固定されたピン層24と、このピン層24におけるスペーサ層23とは反対側の面に隣接するように配置され、ピン層24における磁化の方向を固定する反強磁性層25とを有している。

【0045】

本実施の形態では、ピン層24は、非磁性スペーサ層24bと、この非磁性スペーサ層24bを挟むように配置され2つの強磁性層24a、24cとを含んでいる。ピン層24は、スペーサ層23側から順に強磁性層24a、非磁性スペーサ層24b、強磁性層24cを積層することによって形成される。2つの強磁性層24a、24cは、反強磁性結合し、磁化の方向が互いに逆方向に固定されている。

【0046】

下地層21の厚さは、例えば4～6nmである。下地層21の材料としては、例えばTaやNiCrが用いられる。

【0047】

フリー層22の厚さは、例えば3～8nmである。フリー層22は、単層で構成されていてもよいし、2つ以上の層によって構成されていてもよい。ここでは、フリー層22が2つの軟磁性層で構成される場合の例を挙げる。2つの層のうち、下地層21側の層を第1の軟磁性層と呼び、スペーサ層23側の層を第2の軟磁性層と呼ぶ。

【0048】

第1の軟磁性層の厚さは、例えば1～8nmである。第1の軟磁性層は、例えば、Ni、Co、Fe、Ta、Cr、Rh、MoおよびNbからなる群のうち少なくともNiを含む磁性材料により構成されている。具体的には、第1の軟磁性層は、 $[\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Fe}_{100-(x+y)}]_{100-z}\text{M}_{\text{IZ}}$ により構成されることが好ましい。式中、 M_{I} は、Ta、Cr、Rh、MoおよびNbのうち少なくとも1種を表し、 x 、 y 、 z はそれぞれ原子%で $75 \leq x \leq 90$ 、 $0 \leq y \leq 15$ 、 $0 \leq z \leq 15$ の範囲内である。

【0049】

第2の軟磁性層の厚さは、例えば0.5～3nmである。第2の軟磁性層は、例えば、Ni、CoおよびFeからなる群のうちの少なくともCoを含む磁性材料により構成されている。具体的には、第2の軟磁性層は、(111)面が積層方向に配向している $\text{Co}_x\text{Fe}_y\text{Ni}_{100-(x+y)}$ により構成されることが好ましい。式中、 x 、 y はそれぞれ原子%で $70 \leq x \leq 100$ 、 $0 \leq y \leq 25$ の範囲内である。

【0050】

スペーサ層23の厚さは、例えば1.8～3.0nmである。スペーサ層23は、例えば、Cu、AuおよびAgからなる群のうち少なくとも1種を80重量%以上含む非磁性の導電性材料により構成されている。

【0051】

ピンド層 24 の強磁性層 24 a, 24 c は、例えば、Co および Fe からなる群のうちの少なくとも Co を含む強磁性材料により構成されている。特に、この磁性材料の (111) 面は積層方向に配向していることが好ましい。強磁性層 24 a, 24 c とを合わせた厚さは、例えば 3 ~ 4.5 nm である。

【0052】

非磁性スペーサ層 24 b の厚さは、例えば 0.2 ~ 1.2 nm である。非磁性スペーサ層 24 b は、例えば、Ru、Rh、Re、Cr および Zr からなる群のうち少なくとも 1 種を含む非磁性材料により構成されている。この非磁性スペーサ層 24 b は、強磁性層 24 a と強磁性層 24 c との間に反強磁性交換結合を生じさせ、強磁性層 24 a の磁化と強磁性層 24 c の磁化とを互いに逆方向に固定するためのものである。なお、強磁性層 24 a の磁化と強磁性層 24 c の磁化が互いに逆方向というのは、これら 2 つの磁化の方向が互いに 180° 異なる場合のみならず、2 つの磁化の方向が $180^\circ \pm 20^\circ$ 異なる場合を含む。

【0053】

反強磁性層 25 の厚さは、例えば 5 ~ 30 nm である。反強磁性層 25 は、例えば、Pt、Ru、Rh、Pd、Ni、Au、Ag、Cu、Ir、Cr および Fe からなる群のうちの少なくとも 1 種 M_{II} と、Mn とを含む反強磁性材料により構成されている。このうち Mn の含有量は 35 原子%以上 95 原子%以下、その他の元素 M_{II} の含有量は 5 原子%以上 65 原子%以下であることが好ましい。この反強磁性材料には、熱処理しなくても反強磁性を示し、強磁性材料との間に交換結合磁界を誘起する非熱処理系反強磁性材料と、熱処理により反強磁性を示すようになる熱処理系反強磁性材料とがある。この反強磁性層 25 は、そのどちらにより構成されていてもよい。

【0054】

なお、非熱処理系反強磁性材料には γ 相を有する Mn 合金等があり、具体的には、RuRhMn、FeMn あるいは IrMn 等がある。熱処理系反強磁性材料には規則結晶構造を有する Mn 合金等があり、具体的には、PtMn、NiMn および PtRhMn 等がある。

【0055】

キャップ層 2 6 の厚さは、例えば 4 ～ 6 n m である。キャップ層 2 6 の材料としては、例えば T a が用いられる。

【 0 0 5 6 】

図 1 に示したバイアス磁界印加層 1 8 は、硬磁性層（ハードマグネット）や、強磁性層と反強磁性層との積層体等によって構成される。ここでは、バイアス磁界印加層 1 8 が、下部シールドギャップ膜 4 側に配置された強磁性層と、この強磁性層の上に形成された反強磁性層との積層体によって構成される場合の例を挙げる。この場合、強磁性層の厚さは、例えば 1 0 ～ 4 0 n m である。強磁性層は、例えば、N i F e、N i F e と C o F e の積層膜あるいは N i、F e、C o からなる群のうちの少なくとも 1 種を含む磁性材料により構成されている。反強磁性層の厚さは、例えば 1 0 ～ 2 0 n m である。反強磁性層は、例えば、非熱処理系反強磁性材料で構成されてもよいし、熱処理系反強磁性材料で構成されてもよいが、非熱処理系反強磁性材料のほうが好ましい。

【 0 0 5 7 】

バイアス磁界印加層 1 8 は、上記の例に限らず、例えば、T i W と C o P t との積層体、あるいは T i W と C o C r P t との積層体のような硬磁性層で構成してもよい。

【 0 0 5 8 】

図 1 に示した電極層 6 は、T a と A u との積層体、T i w と T a の積層体、あるいは T i N と T a の積層体等によって構成される。

【 0 0 5 9 】

次に、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドの作用について説明する。薄膜磁気ヘッドは、記録ヘッドによって記録媒体に情報を記録し、再生ヘッドである磁気抵抗効果装置によって、記録媒体に記録されている情報を再生する。

【 0 0 6 0 】

ここで、図 2 に示したように、磁気抵抗効果装置のバイアス磁界印加層 1 8 によるバイアス磁界の方向を X 方向とし、エアベアリング面 3 0 に垂直な方向を Y 方向とする。X 方向と Y 方向は直交している。MR 素子 5 において、信号磁界が

ない状態では、フリー層 2 2 の磁化の方向は、バイアス磁界の方向である X 方向に揃えられている。一方、ピン層 2 4 では、強磁性層 2 4 c の磁化の方向は、反強磁性層 2 5 によって Y 方向に固定され、強磁性層 2 4 a の磁化の方向は、強磁性層 2 4 c の磁化の方向とは逆方向の Y 方向に固定されている。

【 0 0 6 1 】

MR 素子 5 では、記録媒体からの信号磁界に応じてフリー層 2 2 の磁化の方向が変化し、これにより、フリー層 2 2 の磁化の方向とピン層 2 4 の強磁性層 2 4 a の磁化の方向との間の相対角度が変化し、その結果、MR 素子 5 の抵抗値が変化する。MR 素子 5 の抵抗値は、2 つの電極層 6 によって MR 素子 5 にセンス電流を流したときの 2 つの電極層 6 間の電位差より求めることができる。このようにして、磁気抵抗効果装置によって、記録媒体に記録されている情報を再生することができる。

【 0 0 6 2 】

次に、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドの特徴の一つである電極層 6 のオーバーラップ量の規定と、それによる作用、効果について説明する。以下の説明では、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップするように配置され、各電極層 6 のオーバーラップ量は共に $0.15 \mu\text{m}$ 未満であり、且つ等しいものとする。また、この場合における一方の電極層 6 のオーバーラップ量を L_0 とする。

【 0 0 6 3 】

ハードディスク装置の高記録密度化に伴い、薄膜磁気ヘッドでは、書き込みトラック幅および読み出しトラック幅の縮小が要求される。そこで、実験により、磁気抵抗効果装置における電極層 6 のオーバーラップ量 L_0 が読み出しトラック幅に与える影響について調べた。この実験では、図 7 に示したように 2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置、すなわちオーバーラップ量 L_0 がゼロの磁気抵抗効果装置と、図 8 に示したように 2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置であって、オーバーラップ量 L_0 が $0.05 \mu\text{m}$ 、 $0.10 \mu\text{m}$ 、 $0.15 \mu\text{m}$ 、 $0.20 \mu\text{m}$ の 4 種類の磁気抵抗効果装置について、それぞれ、20

0 個ずつ製造し、それらの出力と実効的な磁氣的読み出しトラック幅 (magnetic read width) とを調べた。

【 0 0 6 4 】

以下の説明では、図 7 および図 8 に示したように、光学的な磁氣的読み出しトラック幅となる 2 つの電極層 6 の間隔 (以下、電極間隔と言う。) を符号 MRT1 で表し、MR 素子 5 の上面における幅 (以下、素子幅と言う。) を符号 MRT2 で表す。また、図 7 に示したオーバーラップ量 L_0 がゼロの磁気抵抗効果装置の出力を基準として各磁気抵抗効果装置の出力を百分率で表したものを、規格化出力と言い、符号 Norm_TAA で表す。また、実効的な磁氣的読み出しトラック幅 (以下、実効トラック幅と言う。) の平均値を符号 MRW_mean で表し、実効トラック幅の標準偏差を符号 MRW_std で表し、実効トラック幅のばらつき (標準偏差の 3 倍) を符号 MRW_3std で表し、実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値を符号 MRW_max(3std) で表す。

【 0 0 6 5 】

なお、実効トラック幅は、薄膜磁気ヘッドをトラック横断方向に移動させて再生ヘッドの出力をモニタリングしたときの出力の半値幅より測定した。

【 0 0 6 6 】

また、実験では、実効トラック幅の狙い値を $0.36 \mu\text{m}$ とし、全ての磁気抵抗効果装置について電極間隔 MRT1 を $0.35 \mu\text{m}$ とした。実験結果を、以下の表に示す。

【 0 0 6 7 】

【表 1】

L_0	MRT 1	MRT 2	Norm_TA	MRW_me	MRW_st	MRW_3st	MRW_ma
$[\mu m]$	$[\mu m]$	$[\mu m]$	A	an	d	d	x
			[%]	$[\mu m]$	$[\mu m]$	$[\mu m]$	(3std) $[\mu m]$
0.00	0.35	0.35	100	0.367	0.02	0.06	0.397
0.05	0.35	0.45	148	0.377	0.02	0.06	0.407
0.10	0.35	0.55	167	0.390	0.02	0.06	0.420
0.15	0.35	0.65	183	0.405	0.03	0.08	0.443
0.20	0.35	0.75	197	0.429	0.05	0.15	0.504

【 0 0 6 8 】

この表から、オーバーラップ量 L_0 が大きくなるほど、磁気抵抗効果装置の出力が大きくなることが分かる。オーバーラップ量 L_0 がゼロのときを基準にすると、オーバーラップ量 L_0 が $0.05 \mu m$ のときに既に出力は約 50 % 向上し、オーバーラップ量 L_0 が $0.20 \mu m$ のときには出力は約 2 倍に向上している。

【 0 0 6 9 】

ここで、図 9 および図 10 を参照して、電極層 6 が MR 素子 5 にオーバーラップすることによって磁気抵抗効果装置の出力が大きくなる理由について説明する。図 9 は、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置におけるセンス電流の流れを示している。図 10 は、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置におけるセンス電流の流れを示している。

【 0 0 7 0 】

図 9 および図 10 に示したように、MR 素子 5 の両側にはバイアス磁界印加層 18 が配置されているので、MR 素子 5 においてバイアス磁界印加層 18 に隣接する端部近傍には、バイアス磁界印加層 18 からの磁界によって磁化の方向が固定されて信号磁界を感知することができない領域（以下、不感領域と言う。）5B が生じる。この不感領域 5B は磁気抵抗効果装置の出力に寄与しない。MR 素

子 5 のうち、不感領域 5 B 以外の領域は、信号磁界を感知することができる活性化領域 5 A となる。

【 0 0 7 1 】

図 9 に示したように、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置では、センス電流が 2 つの不感領域 5 B を通過するため、出力が低下する。これに対し、図 1 0 に示したように、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置では、2 つの電極層 6 が MR 素子 5 の活性化領域 5 A の上にまで存在しているので、図 9 に示した磁気抵抗効果装置に比べて、不感領域 5 B を通過するセンス電流の割合が減る。図 1 0 に示した磁気抵抗効果装置では、特に、信号磁界に応じて MR 素子 5 が低抵抗となった状態において、電流は電気抵抗が小さい所を通過しようとすることから、結果的にセンス電流は活性化領域 5 A のみを通過しようとする。以上のことから、電極層 6 が MR 素子 5 にオーバーラップすることによって磁気抵抗効果装置の出力は大きくなる。

【 0 0 7 2 】

前記の表から分かるように、オーバーラップ量 L_0 が大きくなるほど磁気抵抗効果装置の出力が大きくなる。しかしながら、薄膜磁気ヘッドの特性として要求される実効トラック幅に着目すると、前記の表から、オーバーラップ量 L_0 が大きくなるほど、実効トラック幅に悪影響を与えていることが分かる。この悪影響を分かりやすくするために、オーバーラップ量 L_0 と実効トラック幅の平均値 MRW_{mean} および実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値 $MRW_{max}(3std)$ との関係を、図 1 1 の特性図として示す。図 1 1 には、符号 3 1 で示す実線によって、実効トラック幅の狙い値 ($0.36 \mu m$) のレベルも示している。また、ハードディスク装置の特性を確保するために実効トラック幅に要求される規格の一つとして、実効トラック幅が、その狙い値の $\pm 15\%$ 以内であることが要求される。そこで、実効トラック幅の狙い値 ($0.36 \mu m$) $+ 15\%$ の値を規格最大値とする。図 1 1 には、符号 3 2 で示す破線によって、規格最大値のレベルも示している。

【 0 0 7 3 】

前記の表および図 1 1 から、電極間隔MRT1が0. 3 5 μ mで一定であるにも関わらず、オーバーラップ量 L_0 の増加と共に、実効トラック幅の平均値MRW_meanと実効トラック幅のばらつきMRW_3stdが大きくなっていることが分かる。この現象が生じる理由の一つとしては、次のようなことが考えられる。すなわち、オーバーラップ量 L_0 が増加すると、電極間隔MRT1は一定であるが素子幅MRT2は大きくなるため、縦バイアス磁界の効果が薄れ、その結果、実効トラック幅が不安定になると考えられる。

【 0 0 7 4 】

図 1 1 から分かるように、オーバーラップ量 L_0 が0. 1 5 μ mのときには、実効トラック幅の平均値MRW_meanは規格最大値に極めて近く、実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値MRW_max(3std)は、規格最大値よりも約0. 0 3 μ m大きくなっている。この場合には、製造される全ヘッドのうち、実効トラック幅が規格最大値を越えるヘッドの割合がかなり多くなり、ヘッドの歩留まりが悪くなることが予想される。

【 0 0 7 5 】

オーバーラップ量 L_0 が0. 2 0 μ mになると、実効トラック幅の平均値MRW_meanは規格最大値を越え、実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値MRW_max(3std)は、規格最大値よりも約0. 0 9 μ m大きく、実効トラック幅の狙い値よりも約0. 1 4 μ m大きくなっている。

【 0 0 7 6 】

以上のことから、電極間隔MRT1を0. 3 5 μ mとした場合には、ヘッドの歩留まりの観点から、オーバーラップ量 L_0 を0. 1 5 μ m以上とすることは好ましくない。

【 0 0 7 7 】

電極間隔MRT1を0. 3 5 μ mよりも小さくすれば、オーバーラップ量 L_0 を0. 1 5 μ m以上としても、規格を満たすようなヘッドを製造することが可能である。しかしながら、電極間隔MRT1を0. 3 5 μ mよりも小さくすることは、電極層6の製造に、技術的に大きな負担を与えることになる。

【 0 0 7 8 】

従って、電極層 6 の製造技術およびヘッドの歩留まりの観点から、オーバーラップ量 L_0 は $0.15 \mu\text{m}$ 未満とするのが好ましい。

【0079】

また、図 11 から分かるように、オーバーラップ量 L_0 が $0.10 \mu\text{m}$ の場合には、実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値 $\text{MRW}_{\text{max}}(3\text{std})$ は、規格最大値よりもわずかに大きい程度である。また、オーバーラップ量 L_0 が $0.05 \mu\text{m}$ の場合には、実効トラック幅のばらつきより予想される実効トラック幅の最大値 $\text{MRW}_{\text{max}}(3\text{std})$ は、規格最大値よりも小さくなる。従って、ヘッドの歩留まりを向上させる目的のためには、オーバーラップ量 L_0 は $0.10 \mu\text{m}$ 以下とするのが好ましく、 $0.05 \mu\text{m}$ 以下とするのが、より好ましい。

【0080】

図 12 は、オーバーラップ量 L_0 と規格化出力 Norm_TAA との対応関係を示す特性図である。この図から、オーバーラップ量 L_0 がわずかでもあれば、出力の向上が期待できることが分かる。

【0081】

図 13 は、図 12 におけるオーバーラップ量 L_0 が $0 \sim 0.06 \mu\text{m}$ の範囲を拡大して示す特性図である。出力の測定誤差を $\pm 5\%$ 見込んでも、規格化出力 Norm_TAA が 105% 以上であれば、確実に出力の向上は期待できる。規格化出力 Norm_TAA が 105% となるオーバーラップ量 L_0 は約 $0.003 \mu\text{m}$ である。従って、オーバーラップ量 L_0 は $0.003 \mu\text{m}$ 以上とするのが好ましい。

【0082】

次に、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドにおいて、バイアス磁界印加層 18 は MR 素子 5 の上面にオーバーラップせず、電極層 6 は MR 素子 5 の上面にオーバーラップしていることによる作用、効果について説明する。

【0083】

図 14 および図 15 に、本実施の形態に対する 2 つの比較例の磁気抵抗効果装置を示す。図 14 に示した磁気抵抗効果装置では、バイアス磁界印加層 18 は M

R素子5の上面にオーバーラップしているが、電極層6はMR素子5の上面にオーバーラップしていない。図15に示した磁気抵抗効果装置では、バイアス磁界印加層18と電極層6の双方がMR素子5の上面にオーバーラップしている。図14および図15に示したように、バイアス磁界印加層18がMR素子5の上面にオーバーラップしていると、MR素子5のフリー層において、バイアス磁界印加層18がMR素子5の上面にオーバーラップしている領域の下の部分に、磁化の方向がバイアス磁界印加層18によって設定しようとする磁化の方向とは逆方向となる磁区5Cが生じる。その結果、バルクハウゼンノイズの発生率が増加してしまう。なお、図14および図15において、矢印は磁化の方向を表している。

【0084】

図15に示したように、バイアス磁界印加層18と電極層6の双方をMR素子5の上面にオーバーラップさせれば、磁区5Cを通過するセンス電流の割合が減るので、図14に示した磁気抵抗効果装置に比べれば、バルクハウゼンノイズの発生率を抑えることができる。しかし、それでも、図15に示した磁気抵抗効果装置では、バイアス磁界印加層18がMR素子5の上面にオーバーラップせずに、電極層6がMR素子5の上面にオーバーラップしている構造の磁気抵抗効果装置に比べると、バルクハウゼンノイズの発生率は大きくなる。

【0085】

上記のことを確認するための実験を行った。この実験では、タイプA、B、CおよびDの4種類の磁気抵抗効果装置について、電極間隔MRT1とバルクハウゼンノイズの発生率との関係を調べた。以下の説明では、一方のバイアス磁界印加層18がMR素子5の上面にオーバーラップする領域の長さを、バイアス磁界印加層18のオーバーラップ量と言い、 L_1 で表す。なお、電極層6のオーバーラップ量は、前の説明と同様に L_0 で表す。

【0086】

タイプAの磁気抵抗効果装置は、図7に示したように、バイアス磁界印加層18と電極層6の双方がMR素子5の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置である。タイプAでは、 L_1 と L_0 が共に $0.00\mu\text{m}$ である。

【0087】

タイプBの磁気抵抗効果装置は、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置の一例である。タイプBの磁気抵抗効果装置では、バイアス磁界印加層18はMR素子5の上面にオーバーラップせずに、電極層6はMR素子5の上面にオーバーラップしている。タイプBでは、 L_1 を $0.00\mu\text{m}$ とし、 L_0 を $0.10\mu\text{m}$ としている。

【0088】

タイプCの磁気抵抗効果装置は、図15に示したように、バイアス磁界印加層18と電極層6の双方がMR素子5の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置である。タイプCでは、 L_1 を $0.08\mu\text{m}$ とし、 L_0 を $0.10\mu\text{m}$ としている。

【0089】

タイプDの磁気抵抗効果装置は、図14に示したように、バイアス磁界印加層18はMR素子5の上面にオーバーラップしているが、電極層6はMR素子5の上面にオーバーラップしていない構造の磁気抵抗効果装置である。タイプDでは、 L_1 を $0.08\mu\text{m}$ とし、 L_0 を $0.00\mu\text{m}$ としている。

【0090】

上記の4種類の磁気抵抗効果装置について、電極間隔MRT1とバルクハウゼンノイズの発生率との関係を調べた実験結果を、以下の表と図16に示す。なお、以下の表中の数字は、バルクハウゼンノイズの発生率(%)を表している。

【0091】

【表 2】

MRT1 [μ m]	A	B	C	D
0.2	28.9	8.5	19.8	34.5
0.3	24.0	9.5	16.4	25.4
0.4	18.7	9.5	17.4	24.6
0.5	16.0	11.7	14.3	20.1
0.6	16.0	13.4	14.9	19.1
0.7	14.0	13.2	13.2	16.0
0.8	14.4	12.0	14.2	13.4
0.9	12.4	12.4	12.4	16.0
1.0	13.2	12.2	12.2	15.5

【0092】

上の表と図16から分かるように、電極間隔MRT1が0.6 μ mよりも大きい範囲では、4種類の磁気抵抗効果装置間でバルクハウゼンノイズの発生率に大きな違いはない。しかし、電極間隔MRT1が0.6 μ m以下の範囲では、電極間隔MRT1が小さくなるほど顕著に、4種類の磁気抵抗効果装置間でバルクハウゼンノイズの発生率に違いが生じる。電極間隔MRT1が0.6 μ m以下の範囲では、タイプD、タイプA、タイプC、タイプBの順に、バルクハウゼンノイズの発生率が高くなっている。すなわち、この範囲では、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置であるタイプBの磁気抵抗効果装置におけるバルクハウゼンノイズの発生率は、タイプA、C、Dの磁気抵抗効果装置におけるバルクハウゼンノイズの発生率よりも低くなっている。また、この範囲では、タイプBの磁気抵抗効果装置におけるバルクハウゼンノイズの発生率は、電極間隔MRT1が小さくなるほど低下する。これに対し、タイプA、C、Dの磁気抵抗効果装置におけるバルクハウゼンノイズの発生率は、電極間隔MRT1が小さくなるほど増加する。

【0093】

タイプC、Dの磁気抵抗効果装置において、電極間隔MRT1が小さくなるほどバルクハウゼンノイズの発生率が増加するのは、電極間隔MRT1が小さくなるほど、MR素子5の全幅に対する磁区5Cの幅の割合が大きくなり、磁区5Cの影響が増大するためと考えられる。タイプAの磁気抵抗効果装置において、電極間隔MRT1が小さくなるほどバルクハウゼンノイズの発生率が増加するのは、電極間隔MRT1が小さくなるほど、MR素子5の全幅に対する不感領域の幅の割合が大きくなり、不感領域の影響が増大するためと考えられる。

【0094】

上記の実験結果から、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置によれば、タイプA、C、Dのような他の構造の磁気抵抗効果装置に比べて、バルクハウゼンノイズを低減できることが分かる。また、この実験結果から、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置では、電極間隔MRT1が $0.6\mu\text{m}$ 以下の場合に、バルクハウゼンノイズを低減する効果が顕著になることが分かる。

【0095】

次に、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドの他の特徴であるピンド層24の構造と、それによる作用、効果について説明する。

【0096】

まず、本実施の形態との比較のために製造した比較例の磁気抵抗効果装置について説明する。比較例の磁気抵抗効果装置は、MR素子として、通常のピンド層を含むスピンバルブ型GMR素子を有している。図17は、比較例におけるMR素子105の層の構成を示している。このMR素子105は、下部シールドギャップ膜側から順に積層された下地層121、フリー層122、スペーサ層123、ピンド層124、反強磁性層125およびキャップ層126を有している。ピンド層124は、本実施の形態におけるピンド層24とは異なり、非磁性スペーサ層を有さず、強磁性層のみで構成されている。また、比較例の磁気抵抗効果装置では、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置と同様に、電極層がMR素子の上面にオーバーラップした構造となっており、オーバーラップ量も本実施の形態の場合と等しくなっている。

【0097】

次に、上述の比較例の磁気抵抗効果装置と、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置について、バルクハウゼンノイズの発生率を調べた結果について説明する。バルクハウゼンノイズの発生率は、比較例の磁気抵抗効果装置では15%であったのに対し、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置では0%であった。このことから、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置によれば、バルクハウゼンノイズを十分に低減できることが分かる。

【0098】

以下、図18ないし図20を参照して、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置によってバルクハウゼンノイズを十分に低減できることの理由について説明する。

【0099】

図18は、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および比較例の磁気抵抗効果装置のフリー層22，122の平面図である。MR素子5，105の両側にはバイアス磁界印加層18が配置されているので、図18に示したように、フリー層22，122においてバイアス磁界印加層18に隣接する端部近傍には、バイアス磁界印加層18からの磁界によって磁化の方向が固定されて信号磁界を感知することができない不感領域Bが生じる。フリー層22，122のうち残りの領域は活性化領域Aとなる。しかしながら、電極層がMR素子の上面にオーバーラップした構造の場合には、電極層が活性化領域Aの上にまで存在しているので、活性化領域A内には、その両端近傍に、センス電流が流れにくい領域A₂が生じる。活性化領域A内において、2つの領域A₂の間は、センス電流がよく流れる領域A₁となる。

【0100】

また、図18には、フリー層22，122が受ける磁界とその方向を矢印で表している。図18において、符号41で示す矢印は縦バイアス磁界とその方向を表し、符号42で示す矢印はピン層24，124からの磁界とその方向を表し、符号43で示す矢印はセンス電流によって発生する磁界とその方向を表している。

【0101】

図 1 9 は比較例におけるフリー層 1 2 2 の磁化の状態を示す平面図、図 2 0 は本実施の形態におけるフリー層 2 2 の磁化の状態を示す平面図である。図 1 9 および図 2 0 において、フリー層 1 2 2, 2 2 内の矢印が磁化の方向を表している。図 1 9 および図 2 0 に示したように、フリー層 1 2 2, 2 2 内の活性化領域 A のうち、センス電流がよく流れる領域 A₁ の磁化の方向は縦バイアス磁界 4 1 の方向に一致している。しかし、センス電流が流れにくい領域 A₂ における磁化の方向は、縦バイアス磁界 4 1 の方向とピンド層 1 2 4, 2 4 からの磁界 4 2 の方向との中間の方向になっている。これは、センス電流が流れにくい領域 A₂ では、領域 A₁ に比べて、センス電流によって発生する磁界 4 3 が小さくなり、相対的に、ピンド層 1 2 4, 2 4 からの磁界 4 2 の影響を強く受けるためである。このようにして、フリー層 1 2 2, 2 2 内の活性化領域 A では、磁化の方向が不均一になる。

【 0 1 0 2 】

図 1 9 および図 2 0 に示したように、本実施の形態における領域 A₂ の磁化の方向は、比較例における領域 A₂ の磁化の方向に比べて、縦バイアス磁界 4 1 の方向に近づいている。その理由は、以下の通りである。すなわち、本実施の形態におけるピンド層 2 4 では、2 つの強磁性層 2 4 a, 2 4 c が反強磁性結合しているため、ピンド層 2 4 によって発生される磁界は、2 つの強磁性層 2 4 a, 2 4 c を通過するように閉じている。従って、本実施の形態におけるピンド層 2 4 によって発生される磁界は、比較例における通常のピンド層 1 2 4 によって発生される磁界に比べて、フリー層 2 2, 1 2 4 に与える影響が小さくなる。

【 0 1 0 3 】

以上のことから、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置では、比較例の磁気抵抗効果装置に比べて、フリー層 1 2 2, 2 2 内の活性化領域 A における磁化の方向が均一化される。その結果、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置では、比較例の磁気抵抗効果装置に比べて、バルクハウゼンノイズがより低減される。

【 0 1 0 4 】

ところで、先の電極層 6 のオーバーラップ量の規定に関する説明では、2 つの電極層 6 が共に MR 素子 5 の上面にオーバーラップするように配置され、各電極

層 6 のオーバーラップ量は共に $0.15\ \mu\text{m}$ 未満であり、且つ等しいものとした。しかしながら、このようにヘッドを設計しても、実際に電極層 6 を形成する工程では、2 つの電極層 6 の位置がずれる場合がある。その結果、図 2 1 に示したように、2 つの電極層 6 のオーバーラップ量が異なってしまったり、極端な場合には、図 2 2 に示したように、一方の電極層 6 のみが MR 素子 5 の上面にオーバーラップする場合が生じ得る。

【 0 1 0 5 】

そこで、図 2 1 や図 2 2 に示したように 2 つの電極層 6 のオーバーラップ量が異なる磁気抵抗効果装置を作製して、ヘッドの特性への影響を調べる実験を行った。この実験では、2 つの電極層 6 が MR 素子 5 の一方の面にオーバーラップする領域の合計の長さが $0.3\ \mu\text{m}$ 未満の一定の値になるように、図 8、図 2 1 および図 2 2 に示した各磁気抵抗効果装置を作製し、これらの特性を測定し、比較した。その結果、磁気抵抗効果装置の出力、実効トラック幅の平均値、実効トラック幅のばらつき（標準偏差の 3 倍）およびバルクハウゼンノイズの発生率に関して、図 2 1 および図 2 2 に示した磁気抵抗効果装置であっても、図 8 に示した磁気抵抗効果装置とほぼ同等の特性が得られることが分かった。

【 0 1 0 6 】

従って、本実施の形態では、2 つの電極層 6 のうちの少なくとも一方が、MR 素子 5 の一方の面にオーバーラップし、2 つの電極層 6 のオーバーラップ量の合計が $0.3\ \mu\text{m}$ 未満であればよい。また、ヘッドの歩留まりを向上させる目的のためには、オーバーラップ量の合計は $0.20\ \mu\text{m}$ 以下とするのが好ましく、 $0.10\ \mu\text{m}$ 以下とするのが、より好ましい。また、オーバーラップ量の合計は $0.006\ \mu\text{m}$ 以上とするのが好ましい。

【 0 1 0 7 】

以上説明したように、本実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドならびにそれらの製造方法では、MR 素子 5 の各側部に隣接するようにバイアス磁界印加層 1 8 を設けると共に、2 つの電極層 6 のうちの少なくとも一方を、MR 素子 5 の上面にオーバーラップするように配置している。これにより、本実施の形態によれば、磁気抵抗効果装置（再生ヘッド）の出力の低下を防止しな

がらバルクハウゼンノイズを低減することが可能になり、磁気抵抗効果装置（再生ヘッド）の感度、出力および出力安定性を向上させることができる。

【0108】

また、本実施の形態によれば、2つのバイアス磁界印加層18をMR素子5の上面にオーバーラップしないように配置したので、バルクハウゼンノイズをより低減することができ、これにより、磁気抵抗効果装置（再生ヘッド）の出力安定性をより向上させることができる。

【0109】

また、本実施の形態では、2つの電極層6のオーバーラップ量の合計を0.3 μm 未満としたので、実効読み出しトラック幅を精度よく決定することが可能になる。

【0110】

また、本実施の形態において、電極間隔MRT1が0.6 μm 以下の場合には、バルクハウゼンノイズを低減して、磁気抵抗効果装置（再生ヘッド）の出力安定性を向上させるという効果が顕著になる。

【0111】

また、本実施の形態では、MR素子5を、ピンド層24が、非磁性スペーサ層24bと、この非磁性スペーサ層24bを挟むように配置され、磁化の方向が互いに逆方向に固定された2つの強磁性層24a、24cとを含む構造のスピンバルブ型GMR素子としたので、バルクハウゼンノイズを十分に低減でき、出力安定性をより向上させることができる。

【0112】

[第2の実施の形態]

次に、図23を参照して、本発明の第2の実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドならびにそれらの製造方法について説明する。図23は、本実施の形態におけるMR素子の層の構成を示す斜視図である。本実施の形態におけるMR素子55では、フリー層22が、下地層21側から順に積層された第1の軟磁性層22a、中間層22bおよび第2の軟磁性層22cを含んでいる。中間層22bは、MR素子55の抵抗変化率を大きくするために設けられている

。MR素子55のその他の構成は、第1の実施の形態におけるMR素子5と同様である。

【0113】

中間層22bは、例えば、第1の軟磁性層22aおよび第2の軟磁性層22cよりも電気抵抗が大きく、且つ磁性を有していてもよい。この場合の中間層22bは、センス電流がMR素子55を流れる際に、少なくとも一部の電子を反射して電子の移動する経路を制限することによって、MR素子55の抵抗変化率を大きくする。この場合の中間層22bの厚さは0.5～1nmが好ましい。また、中間層22bは、例えば、酸化物、窒化物または酸化窒化物のうちの少なくとも1種を含んでいることが好ましい。それは、磁氣的に安定であり、出力変動を小さくすることができるからである。また、中間層22bは、第1の軟磁性層22aの構成元素のうちの少なくとも1種を含んでいることが好ましい。それは、第1の軟磁性層22aの一部を酸化、窒化または酸化および窒化することにより、良好な中間層22bを容易に得ることができるからである。また、中間層22bは、Mn、Cr、Ni、Cu、Rh、IrおよびPtからなる群のうちの少なくとも1種を含むようにしてもよい。

【0114】

また、中間層22bは、第1の軟磁性層22aと第2の軟磁性層22cを構成する元素が拡散された金属層であってもよい。この場合には、中間層22bとしては、例えば、膜厚が0.1～0.5nmのTa膜を用いることができる。なお、中間層22bは、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、In、Sn、Hf、Ta、W、Re、Os、IrおよびPtからなる群のうちの少なくとも1種を含むようにしてもよい。MR素子55を構成する各層の形成後にアニーリングを行うことにより、中間層22bには、第1の軟磁性層22aと第2の軟磁性層22cを構成する元素が拡散され、第1の軟磁性層22aと第2の軟磁性層22cには、中間層22bを構成する金属元素が拡散する。この場合の中間層22bは、フリー層22のシート抵抗を大きくすることによって、MR素子55の抵抗変化率を大きくする。

【0115】

なお、本実施の形態において、中間層 2 2 b は、第 1 の軟磁性層 2 2 a の中間や第 2 の軟磁性層 2 2 c の中間に設けてもよい。

【 0 1 1 6 】

本実施の形態によれば、MR 素子 5 5 の抵抗変化率を大きくすることができる。本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第 1 の実施の形態と同様である。

【 0 1 1 7 】

[第 3 の実施の形態]

次に、図 2 4 を参照して、本発明の第 3 の実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および薄膜磁気ヘッドならびにそれらの製造方法について説明する。図 2 4 は、本実施の形態における MR 素子の層の構成を示す斜視図である。本実施の形態における MR 素子 6 5 では、ピンド層 2 4 が反射層 2 4 d を含んでいる。図 2 4 に示した例では、反射層 2 4 d は、強磁性層 2 4 a と非磁性スペーサ層 2 4 b との間に配置されている。

【 0 1 1 8 】

反射層 2 4 d は、強磁性層 2 4 a、2 4 c よりも電気抵抗が大きく、且つ磁性を有している。反射層 2 4 d は、センス電流が MR 素子 6 5 を流れる際に、少なくとも一部の電子を反射して電子の移動する経路を制限することによって、MR 素子 6 5 の抵抗変化率を大きくする。

【 0 1 1 9 】

反射層 2 4 d の厚さは 0.5 ~ 1 nm が好ましい。また、反射層 2 4 d は、例えば、酸化物、窒化物または酸化窒化物のうちの少なくとも 1 種を含んでいることが好ましい。それは、磁氣的に安定であり、出力変動を小さくすることができるからである。また、反射層 2 4 d は、強磁性層 2 4 a の構成元素のうちの少なくとも 1 種を含んでいることが好ましい。それは、強磁性層 2 4 a の一部を酸化、窒化または酸化および窒化することにより、良好な反射層 2 4 d を容易に得ることができるからである。また、反射層 2 4 d は、添加物として、Mn、Cr、Ni、Cu、Rh、Ir および Pt からなる群のうちの少なくとも 1 種を含んでいることが好ましい。それは、熱安定性を向上させることができるからである。

具体的に、反射層 2 4 d は、Ni、Co および Fe からなる群のうちの少なくとも Co と、O および N からなる群のうちの少なくとも 1 種と、Mn、Cr、Ni、Cu、Rh、Ir および Pt からなる群のうちの少なくとも 1 種を含んでいることが好ましい。

【0 1 2 0】

なお、反射層 2 4 d は、強磁性層 2 4 a の中間や強磁性層 2 4 c の中間に設けてもよい。

【0 1 2 1】

本実施の形態によれば、MR 素子 5 5 の抵抗変化率を大きくすることができる。本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第 1 の実施の形態と同様である。

【0 1 2 2】

なお、本発明は、上記各実施の形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、MR 素子の層の構成は、実施の形態に示した例に対して、各層の順序が逆であってもよい。

【0 1 2 3】

また、実施の形態では、基体側に読み取り用の磁気抵抗効果装置を形成し、その上に、書き込み用の誘導型電磁変換素子を積層した構造の薄膜磁気ヘッドについて説明したが、この積層順序を逆にしてもよい。

【0 1 2 4】

また、読み取り専用として用いる場合には、薄膜磁気ヘッドを、読み取り用の磁気抵抗効果装置だけを備えた構成としてもよい。

【0 1 2 5】

また、本発明の磁気抵抗効果装置は、薄膜磁気ヘッドの再生ヘッドに限らず、回転位置センサ、磁気センサ、電流センサ等にも適用することができる。

【0 1 2 6】

【発明の効果】

以上説明したように請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の磁気抵抗効果装置、請求項 4 ないし 6 のいずれかに記載の磁気抵抗効果装置の製造方法、請求項 7 な

いし 9 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド、もしくは請求項 1 0 ないし 1 2 のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、磁気抵抗効果素子の各側部に隣接するようにバイアス磁界印加層を設け、2 つのバイアス磁界印加層を、磁気抵抗効果素子の一方の面に重ならないように配置し、2 つの電極層のうちの少なくとも一方を、磁気抵抗効果素子の一方の面に部分的に重なるように配置するようにしたので、磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドの感度、出力および出力安定性を向上させることができるという効果を奏する。更に、本発明によれば、2 つの電極層が磁気抵抗効果素子の一方の面に重なる領域の合計の長さを $0.3 \mu\text{m}$ 未満としたので、実効読み出しトラック幅を精度よく決定することが可能になるという効果を奏する。

【 0 1 2 7 】

また、請求項 3 記載の磁気抵抗効果装置、請求項 6 記載の磁気抵抗効果装置の製造方法、請求項 9 記載の薄膜磁気ヘッド、もしくは請求項 1 2 記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、2 つの電極層の間隔を $0.6 \mu\text{m}$ 以下としたので、磁気抵抗効果装置または薄膜磁気ヘッドの出力安定性を向上させるという効果を顕著に発揮させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態に係る磁気抵抗効果装置のエアベアリング面に平行な断面を示す断面図である。

【図 2】

本発明の第 1 の実施の形態における MR 素子の層の構成を示す斜視図である。

【図 3】

本発明の第 1 の実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの製造方法における一工程を説明するための断面図である。

【図 4】

図 3 に続く工程を説明するための断面図である。

【図 5】

図 4 に続く工程を説明するための断面図である。

【図 6】

本発明の第 1 の実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの断面図である。

【図 7】

2 つの電極層が共に MR 素子の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 8】

2 つの電極層が共に MR 素子の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 9】

2 つの電極層が共に MR 素子の上面にオーバーラップしない構造の磁気抵抗効果装置におけるセンス電流の流れを示す説明図である。

【図 1 0】

2 つの電極層が共に MR 素子の上面にオーバーラップした構造の磁気抵抗効果装置におけるセンス電流の流れを示す説明図である。

【図 1 1】

オーバーラップ量と実効トラック幅の平均値および実効トラック幅の最大値との関係を示す特性図である。

【図 1 2】

オーバーラップ量と規格化出力との対応関係を示す特性図である。

【図 1 3】

図 1 2 におけるオーバーラップ量が $0 \sim 0.06 \mu\text{m}$ の範囲を拡大して示す特性図である。

【図 1 4】

バイアス磁界印加層は MR 素子の上面にオーバーラップしているが、電極層は MR 素子の上面にオーバーラップしていない磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 1 5】

バイアス磁界印加層と電極層の双方が MR 素子の上面にオーバーラップしている磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 1 6】

4 種類 of 磁気抵抗効果装置について電極間隔とバルクハウゼンノイズの発生率との関係を調べた実験結果を示す特性図である。

【図 1 7】

比較例におけるMR素子の層の構成を示す斜視図である。

【図 1 8】

本発明の第 1 の実施の形態に係る磁気抵抗効果装置および比較例の磁気抵抗効果装置のフリー層の平面図である。

【図 1 9】

比較例におけるフリー層の磁化の状態を示す平面図である。

【図 2 0】

本発明の第 1 の実施の形態におけるフリー層の磁化の状態を示す平面図である。

【図 2 1】

2 つの電極層のオーバーラップ量が異なる磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 2 2】

一方の電極層のみがMR素子の上面にオーバーラップする磁気抵抗効果装置を示す説明図である。

【図 2 3】

本発明の第 2 の実施の形態におけるMR素子の層の構成を示す斜視図である。

【図 2 4】

本発明の第 3 の実施の形態におけるMR素子の層の構成を示す斜視図である。

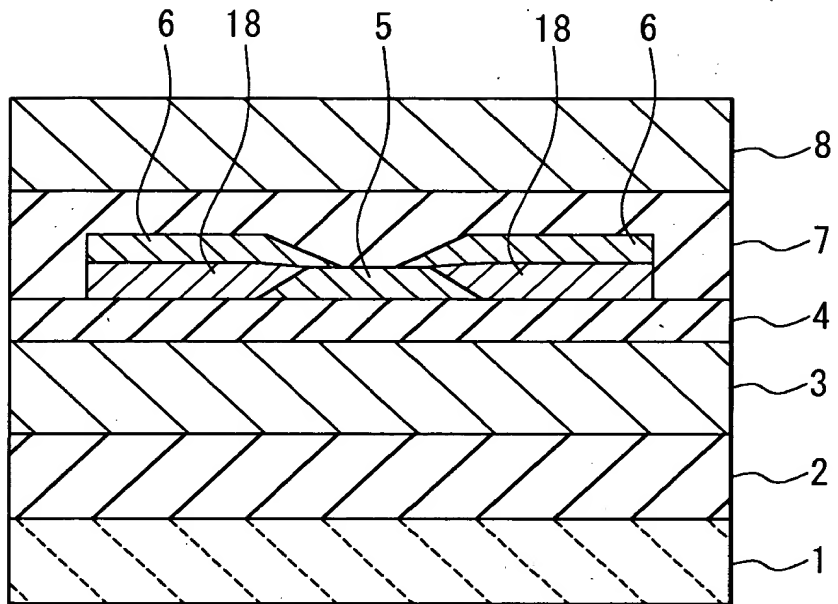
【符号の説明】

1 … 基板、 2 … 絶縁層、 3 … 下部シールド層、 4 … 下部シールドギャップ膜、
5 … MR 素子、 6 … 電極層、 7 … 上部シールドギャップ膜、 8 … 上部シールド層、 9 … 記録ギャップ層、 1 1 … 薄膜コイルの第 1 層部分、 1 3 … 薄膜コイルの第 2 層部分、 1 5 … 上部磁極層、 1 6 … 保護層、 1 8 … バイアス磁界印加層、 2 1 … 下地層、 2 2 … フリー層、 2 3 … スペーサ層、 2 4 … ピンド層、 2 4 a … 強

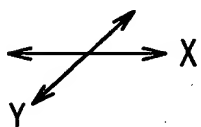
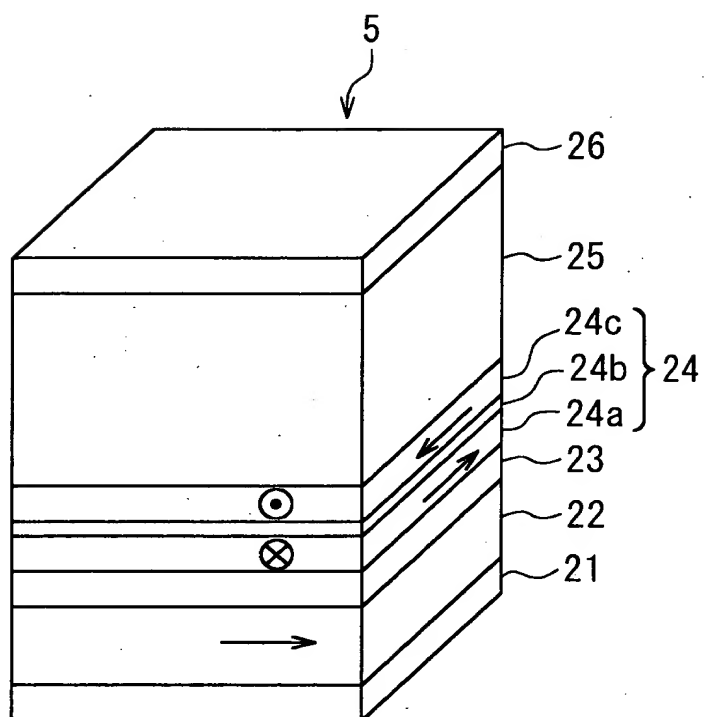
磁性層、2 4 b …非磁性スペーサ層、2 4 c …強磁性層、2 5 …反強磁性層、2
6 …キャップ層。

【書類名】 図面

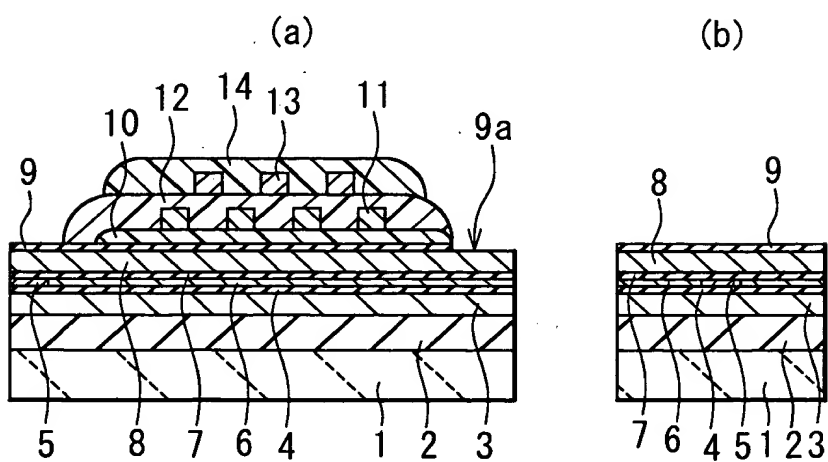
【図 1】



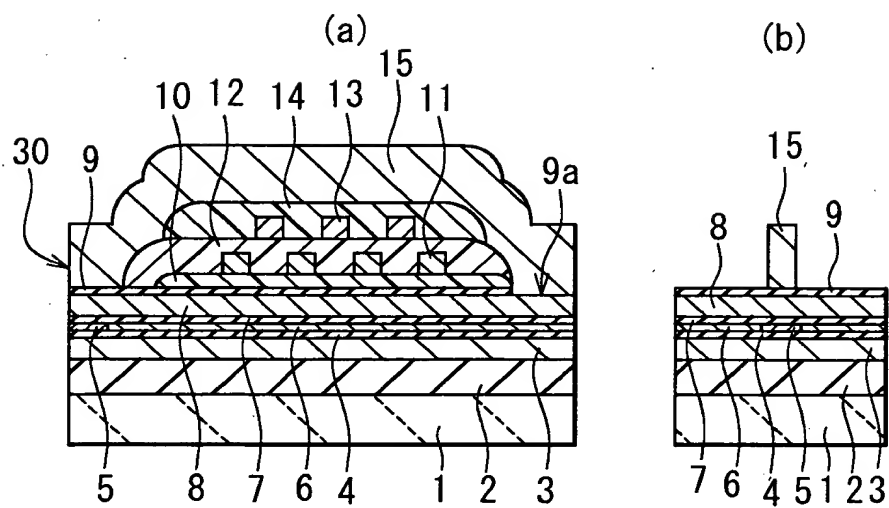
【図 2】



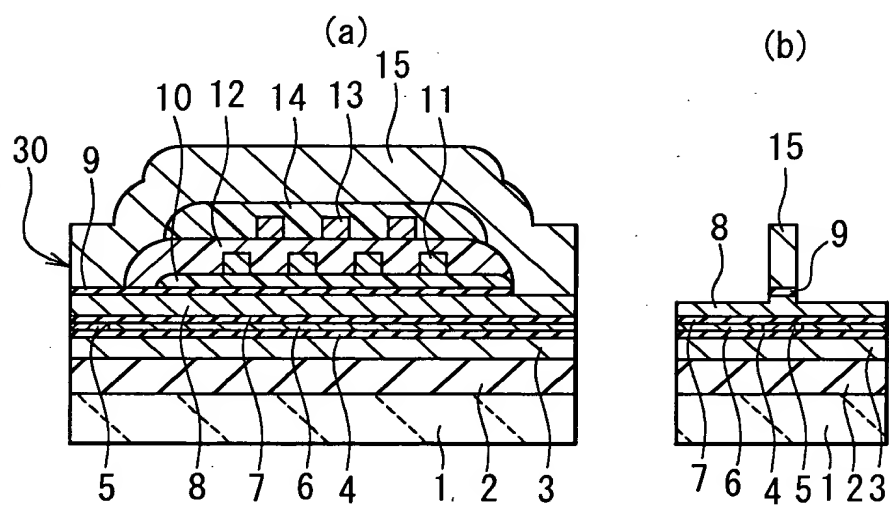
【図 3】



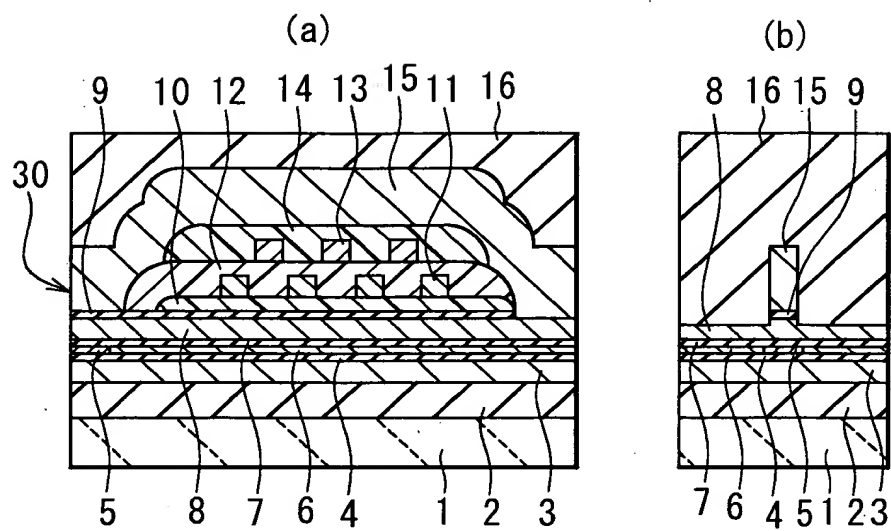
【図 4】



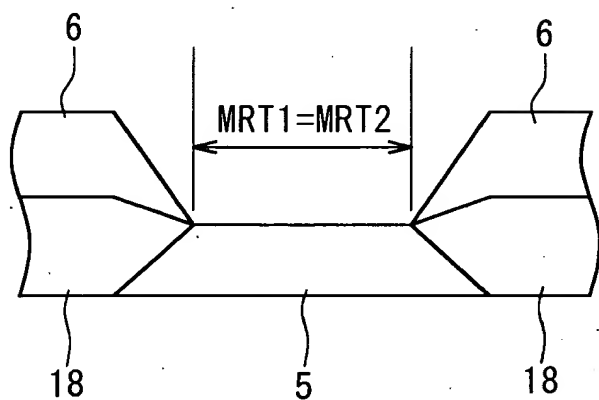
【図 5】



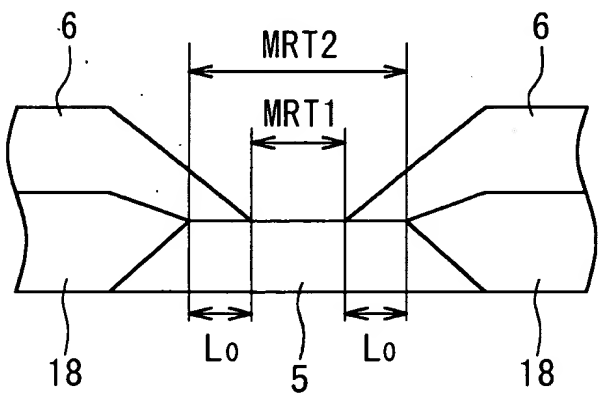
【図 6】



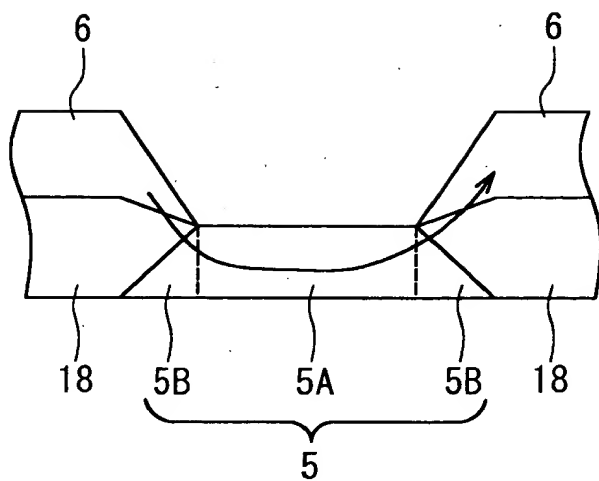
【図 7】



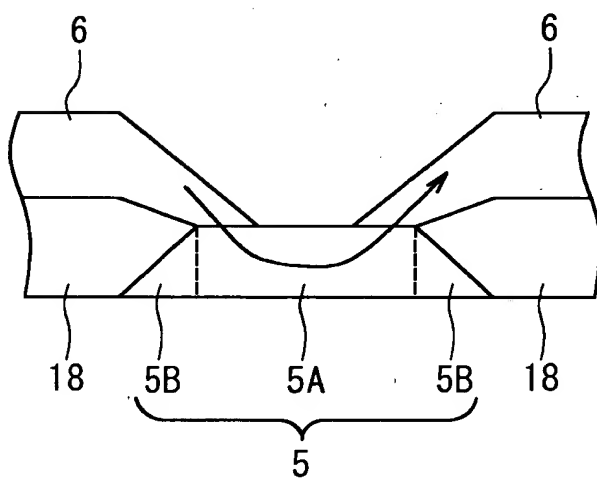
【図 8】



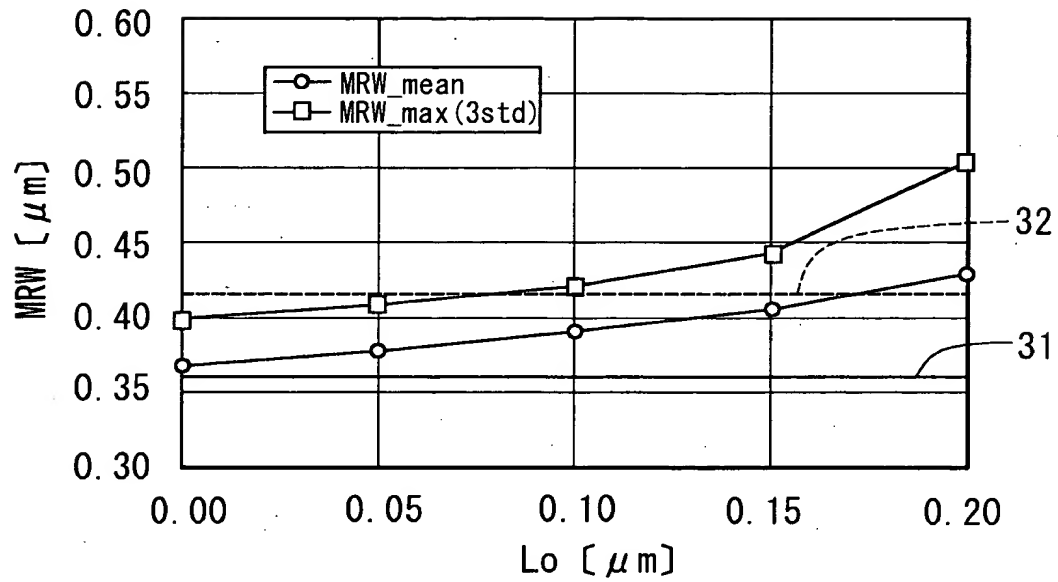
【図 9】



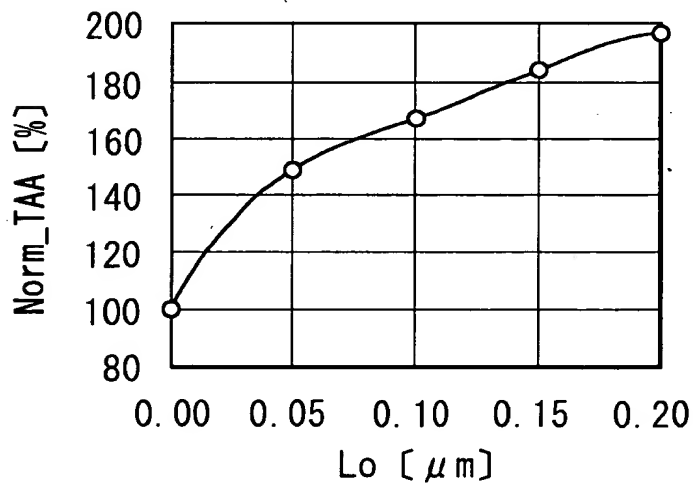
【図 1 0】



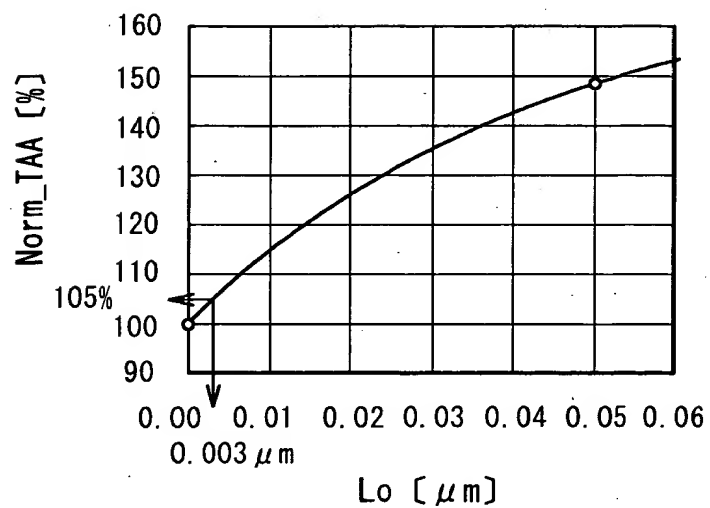
【図 1 1】



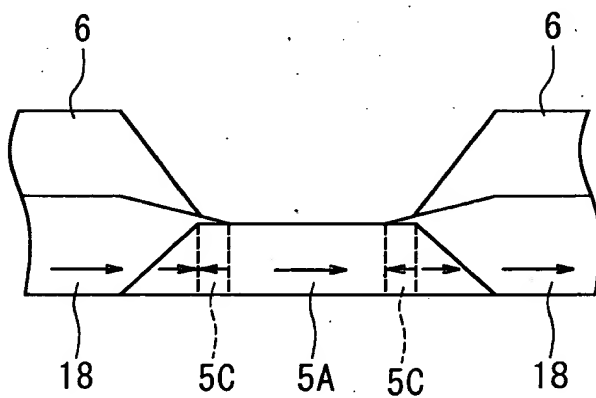
【図 1 2】



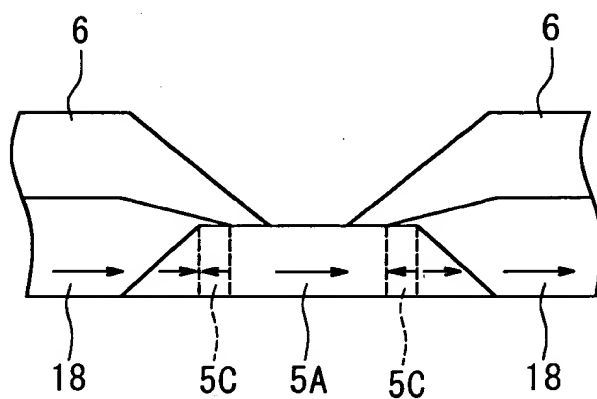
【図 1 3】



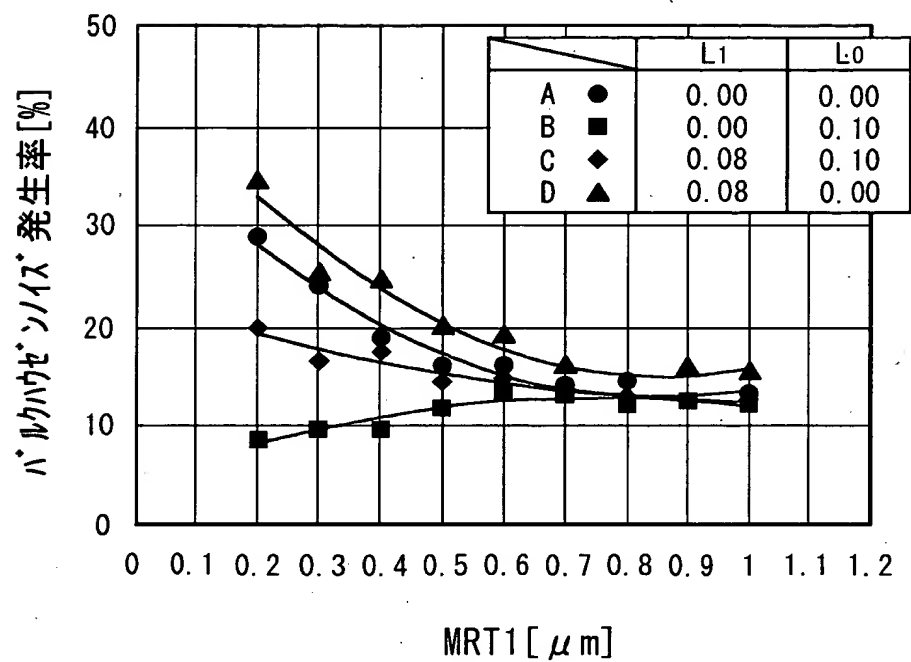
【図 1 4】



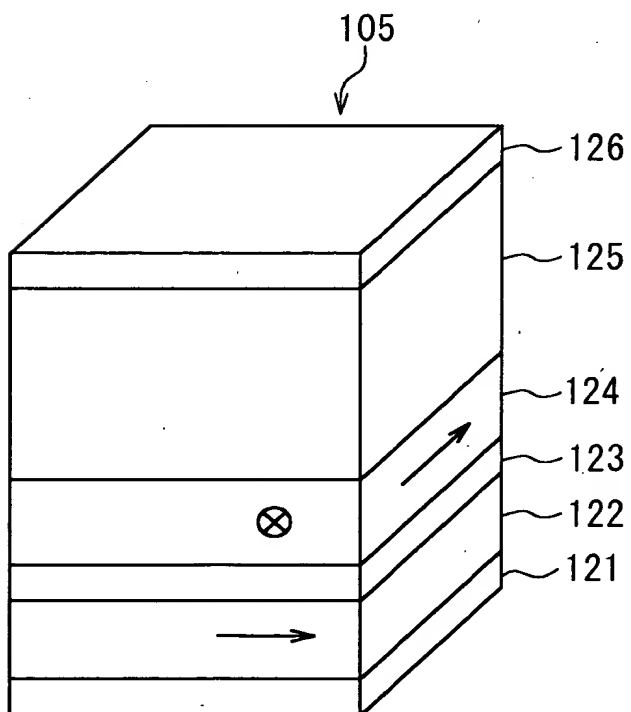
【図 1 5】



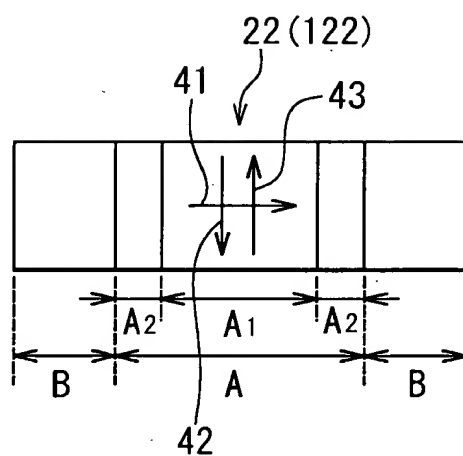
【図 16】



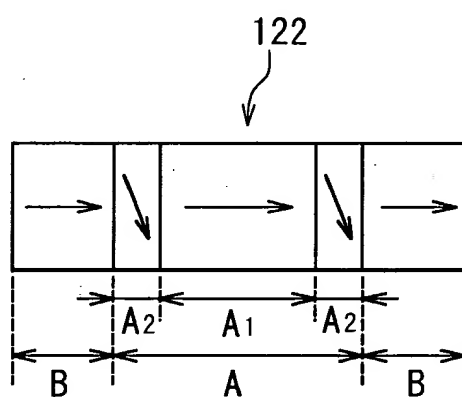
【図 17】



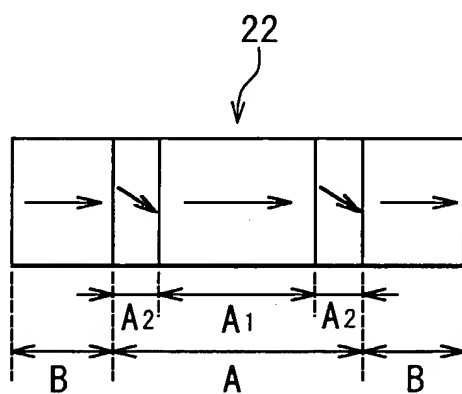
【図 1 8】



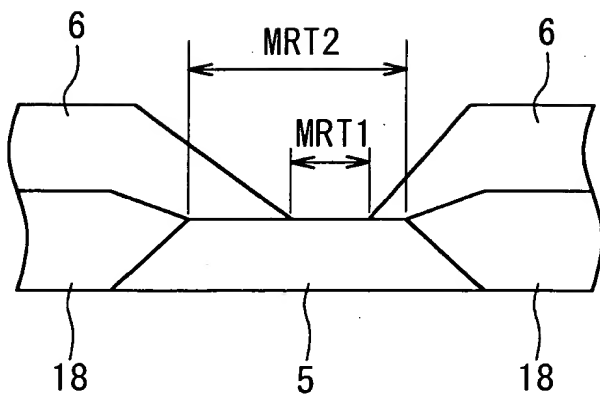
【図 1 9】



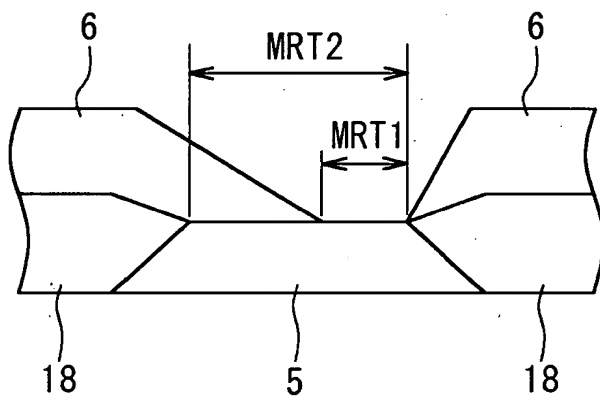
【図 2 0】



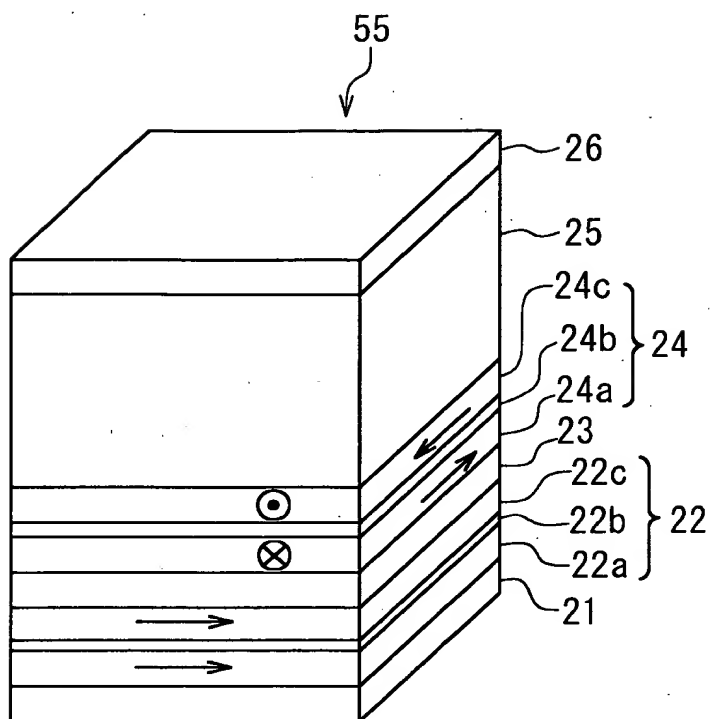
【図 2 1】



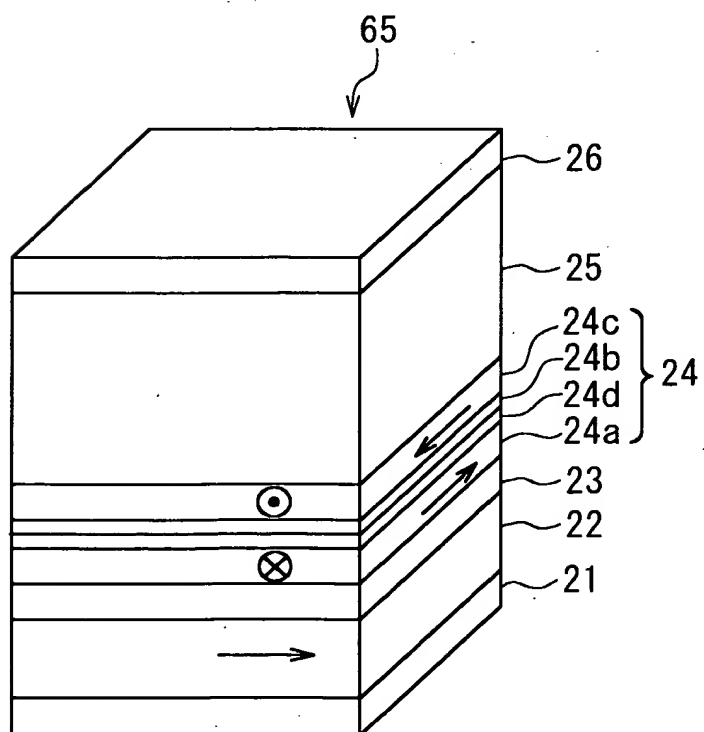
【図 2 2】



【図 2 3】



【図 2 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気抵抗効果装置の感度、出力および出力安定性を向上させると共に、実効読み出しトラック幅を精度よく決定できるようにする。

【解決手段】 磁気抵抗効果装置は、MR素子5と、このMR素子5の各側部に隣接するように配置されたバイアス磁界印加層18と、MR素子5に対してセンス電流を流す2つの電極層6とを備えている。電極層6はMR素子5の一方の面にオーバーラップするように配置されている。2つの電極層6のオーバーラップ量の合計は0.3 μ m未満である。MR素子5は、スピバルブ型GMR素子となっている。MR素子5は、下から順に積層された下地層、フリー層、スペーサ層、ピンド層、反強磁性層およびキャップ層とを有している。ピンド層は、非磁性スペーサ層と、この非磁性スペーサ層を挟むように配置され2つの強磁性層とを含んでいる。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名 ティーディーケイ株式会社